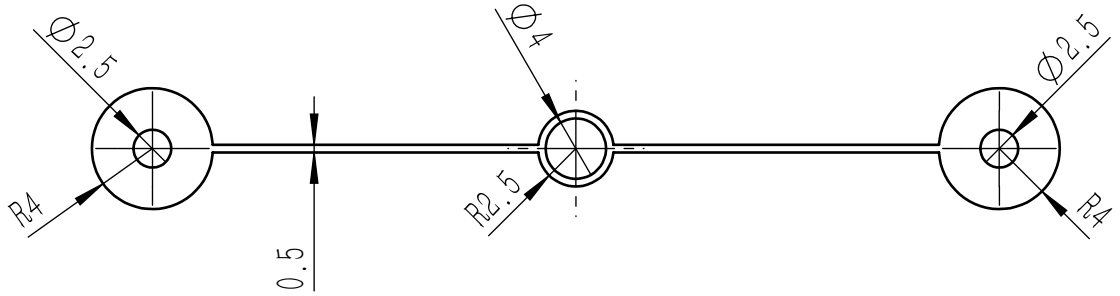
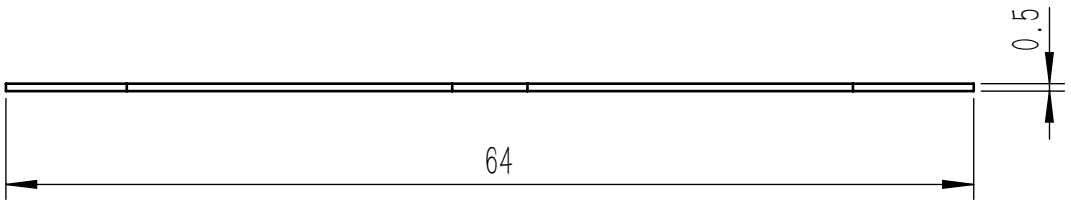
„图样代号„

Ra 3.2





技术要求:

1. 锐边倒钝;
2. 未注公差按IT8等级制造。

数量: 10件

						AISI 类型 316L 不锈钢			中国科学技术大学 国家同步辐射实验室
						阶段标记	质量	比例	电极
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日		0.000	2:1	
设计			标准化						IG-12-01
校核			工艺						
主管设计			审核						
			批准			共1张 第1张	版本		替代

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

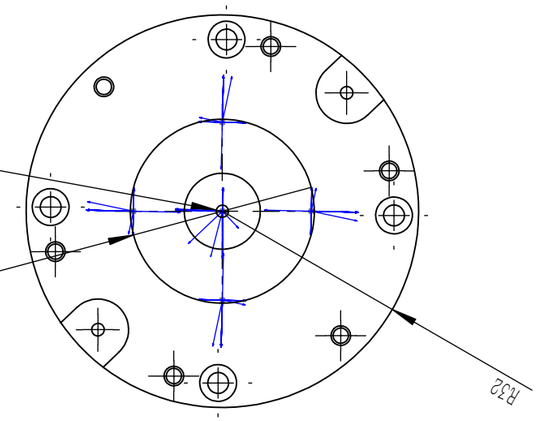
底图总号

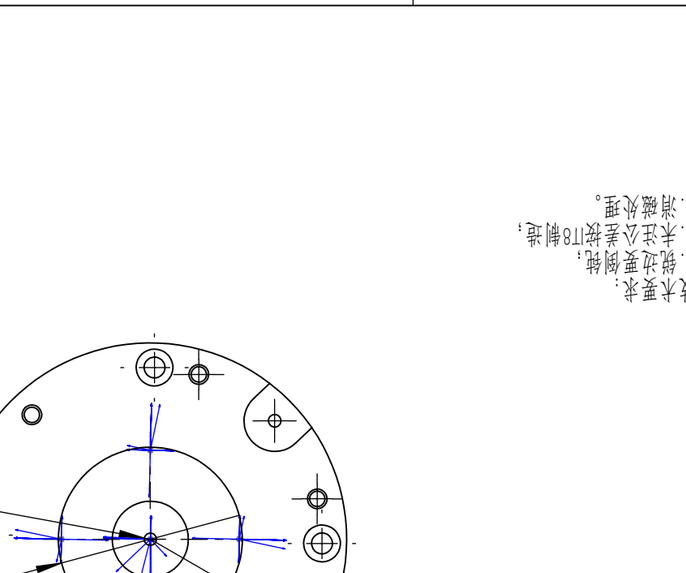
签字

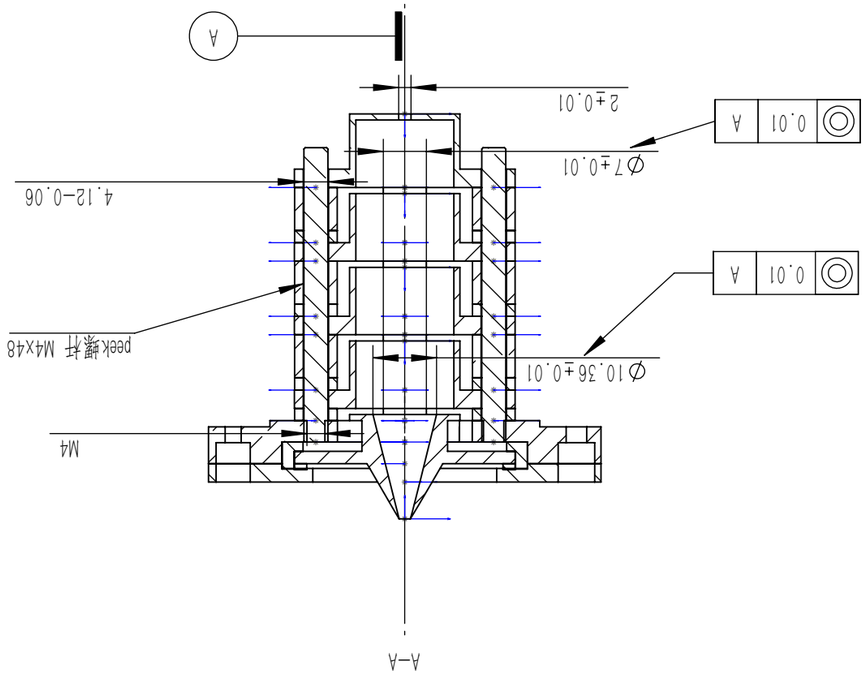
日期

零件代号							
借(通)用件登记							
描图							
描校							
旧底图总号							
底图总号							
签字							
日期							

技术要求：
1.锐边要倒钝；
2.未注公差按IT8制造；
3.消磁处理。







Ra 0.8

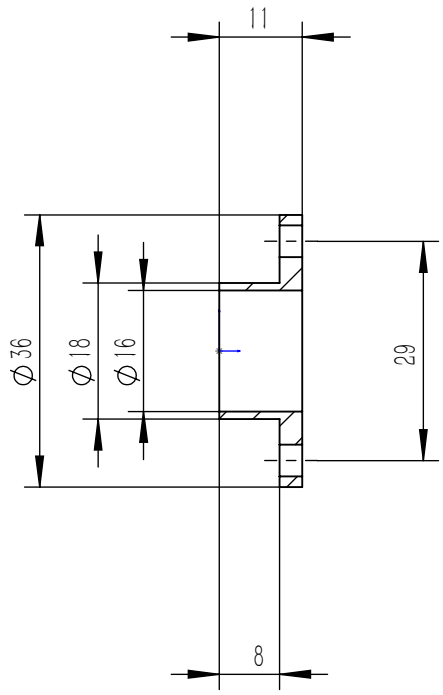
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日

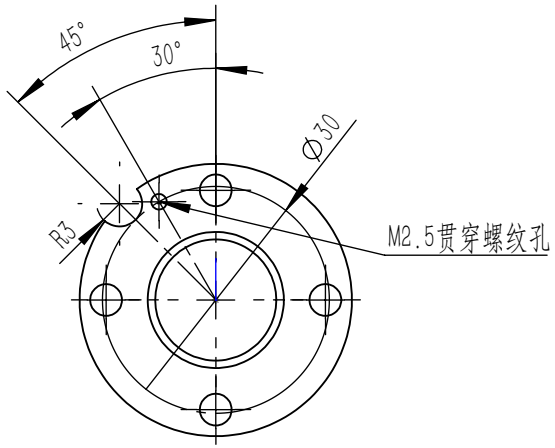
设计		标准化	
校核		工艺	
主管设计		审核	
		批准	

阶段标记	重量	比例	中国科学技术大学 国家同步辐射实验室	
	41	1:1	离子导速器	
			IG-01	
共 1 张 第 1 张	版本		替代	

IG-01

IG-01-10





Ra 0.8

技术要求:
1.锐边要倒钝;
2.未标注的公差按IT8等级制造;
3.消磁处理。

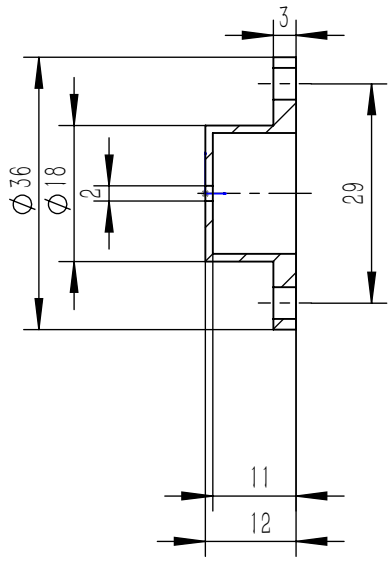
数量: 3件

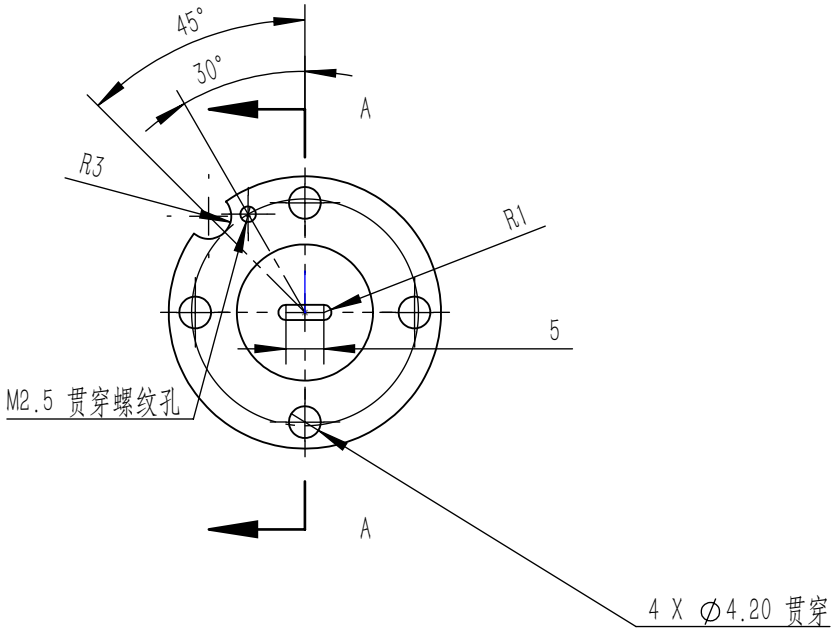
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日
设计			标准化		
校核			工艺		
主管设计			审核		
			批准		

AISI 304		中国科学技术大学 国家同步辐射实验室
阶段标记	质量	比例
	0.003	1:1
		聚焦电极
		IG-01-01
共1张 第1张	版本	替代

零件代号
借(通)用件登记
旧底图总号
底 图 总 号
签 字
日 期

IG-01-02





技术要求：
1.锐边要倒钝；
2.未标注的公差按IT8等级制造；
3.消磁处理；

数量：1件

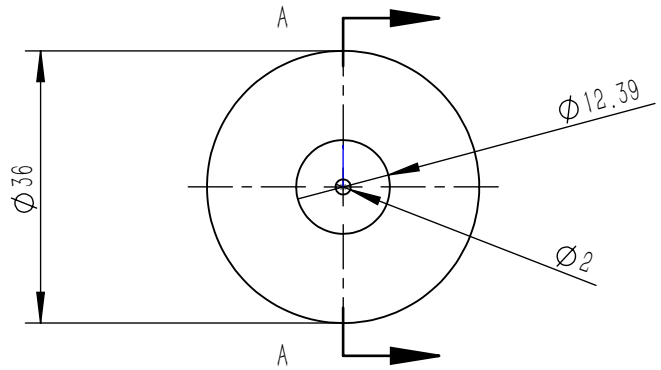
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日
设计			标准化		
校核			工艺		
主管设计			审核		
			批准		

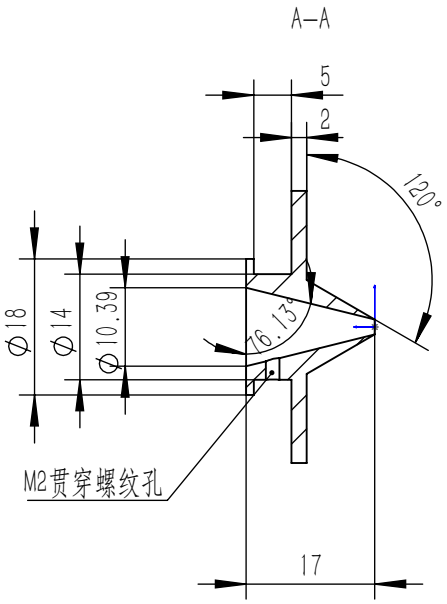
AISI 304		中国科学技术大学 国家同步辐射实验室
阶段标记	质量	比例
	0.003	1:1
		IG-01-02
共1张 第1张	版本	替代

零件代号
借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

IG-01-03

Ra 0.8





技术要求：
1.锐边要倒钝；
2.未标注公差按IT8等级公差制造
3.消磁处理。

数量：1件

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日
设计			标准化		
校核			工艺		
主管设计			审核		
			批准		

SUS316		中国科学技术大学 国家同步辐射实验室
阶段标记	质量	比例
	0.003	1:1
		IG-01-03
共1张 第1张	版本	替代

零件代号
借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

IG-01-04

Ra 0.8

技术要求：
1.锐边要倒钝；
2.未标注的公差按IT8等级制造；
3.消磁处理。

数量：15件

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日
设计			标准化		
校核			工艺		
主管设计			审核		
			批准		

SUS316			中国科学技术大学 国家同步辐射实验室
阶 段 标 记	质量	比例	垫环
	0.000	5:1	
			IG-01-04
共 1 张 第 1 张	版本		替代

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底 图 总 号

签 字

日 期

IG-01-05

技术要求：
1.锐边要倒钝；
2.未标注的公差按IT8等级制造；

数量：18件

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日
设计			标准化		
校核			工艺		
主管设计			审核		
			批准		

PEEK		中国科学技术大学 国家同步辐射实验室
阶 段 标 记	质量	比例
	0.000	5:1
		IG-01-05
共 1 张 第 1 张	版本	替代

零件代号
借(通)用件登记
旧底图总号
底 图 总 号
签 字
日 期

IG-01-07

技术要求：
1.锐边要倒钝；
2.未标注的公差按IT8等级制造；

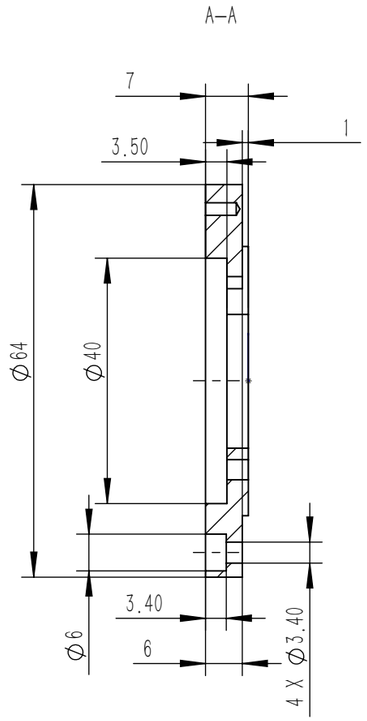
数量：2件

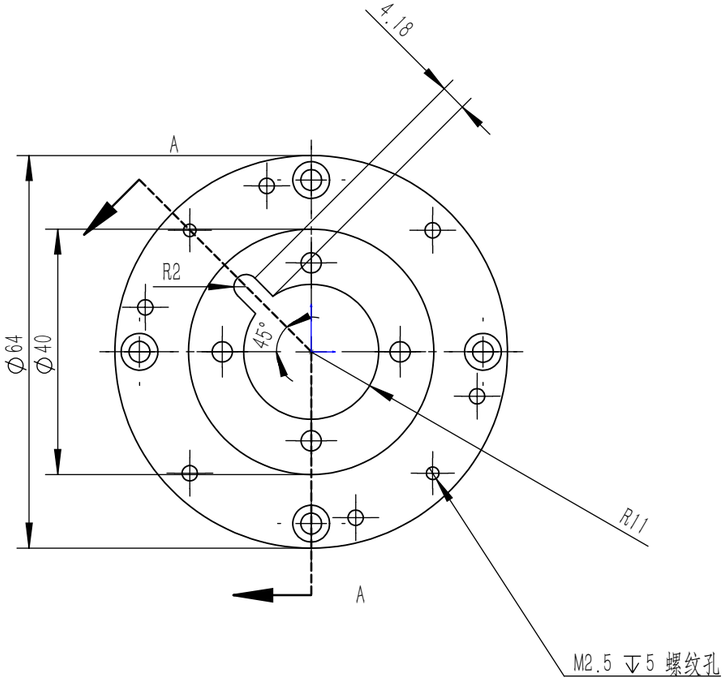
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日
设计			标准化		
校核			工艺		
主管设计			审核		
			批准		

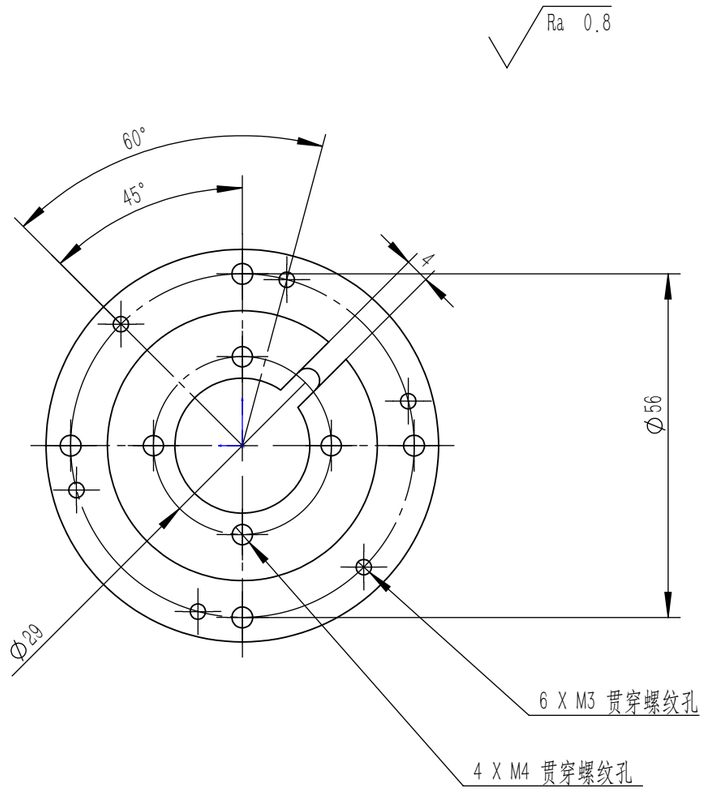
PTFE		中国科学技术大学 国家同步辐射实验室
阶段标记	质量	比例
	0.001	2:1
		IG-01-07
共1张 第1张	版本	替代

零件代号
借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

IG-01-09







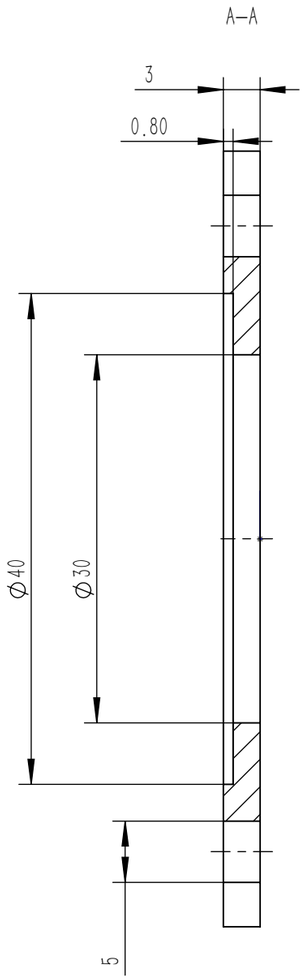
技术要求：
1.锐边要倒钝；
2.未标注公差按IT8等级公差制造；
3.消磁处理。

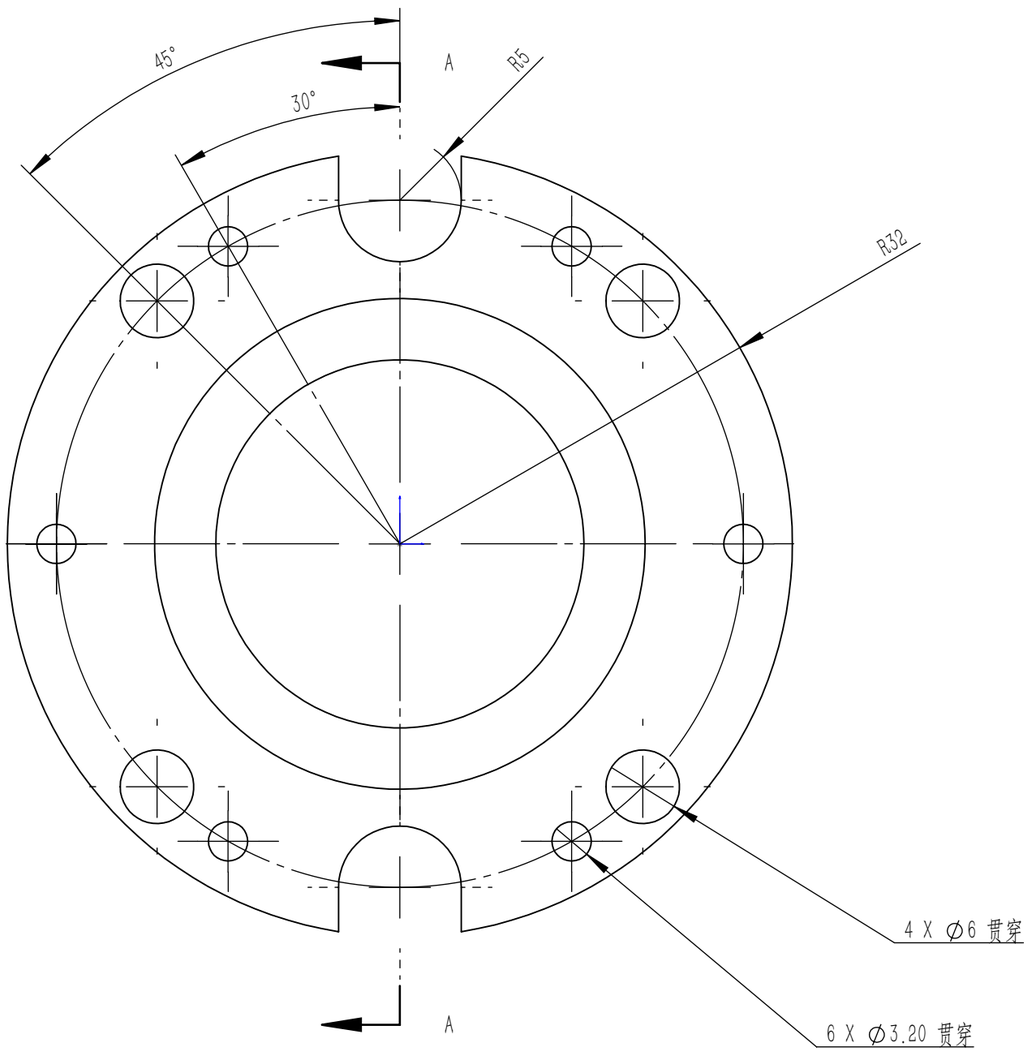
数量：1件

						AISI 316	中国科学技术大学 国家同步辐射实验室
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记	重量	比例	导入器安装法兰
设计			标准化				0.014	1:1	
校核			工艺						IG-01-09
主管设计			审核						
			批准			共 1 张 第 1 张	版本		替代

零件代号
借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期

IG-01-10





Ra 0.8

技术要求：
1.锐边要倒钝；
2.未标注的公差按IT8等级制造；
3.消磁处理。

数量：1件

						AISI 316		中国科学技术大学 国家同步辐射实验室
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记	重量	比例
设计			标准化				0.006	2:1
校核			工艺					
主管设计			审核					IG-01-10
			批准			共 1 张 第 1 张	版本	替代

零 件 代 号

借(通)用件登记

描图

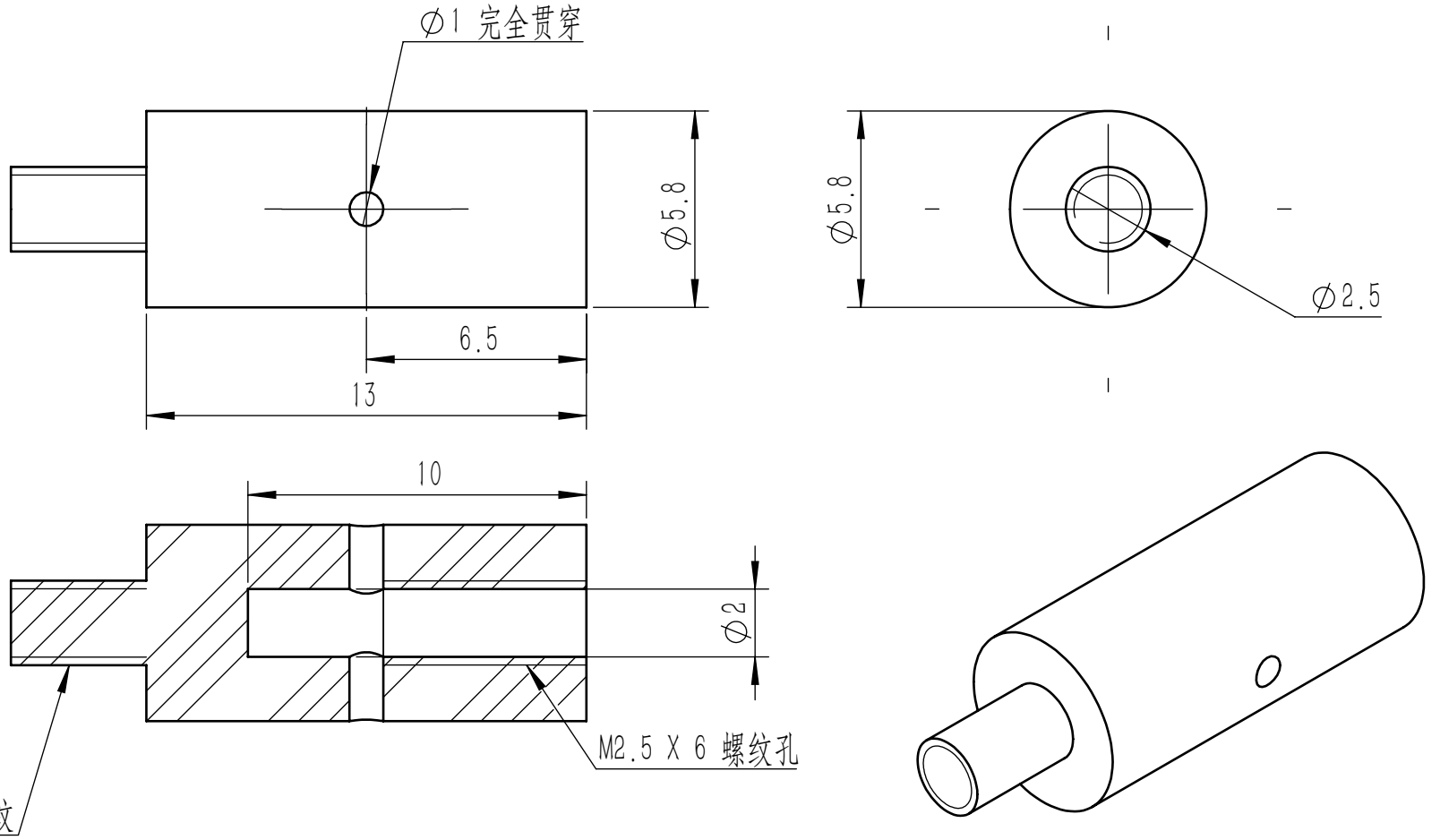
描校

旧底图总号

底图总号

签字

日期



技术要求：
1. 锐边倒钝；
2. 未注公差按IT12等级制造。

数量：10件

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日
设计			标准化		
校核			工艺		
主管设计			审核		
			批准		

PEEK			中国科学技术大学 国家同步辐射实验室
阶段标记	质量	比例	绝缘座
	0.000	5:1	
			IG-11-01
共1张 第1张	版本		替代

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期